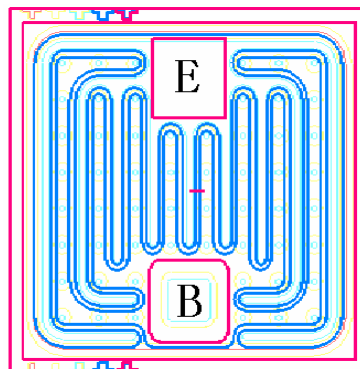




芯片简介

芯片尺寸：4 英寸 (100mm)  
 芯片代码：A075AJ-01  
 芯片厚度：240±20μm  
 管芯尺寸：750×750μm<sup>2</sup>  
 焊位尺寸：B 极 165×170μm<sup>2</sup>；E 极 150×165μm<sup>2</sup>  
 电极金属：铝  
 背面金属：金  
 典型封装：2SA1300

管芯示意图



极限值 (T<sub>a</sub>=25 ) (TO-92)

T<sub>stg</sub>——贮存温度.....-55~150  
 T<sub>j</sub>——结温..... 150  
 P<sub>C</sub>——集电极功率耗散 (T<sub>a</sub>=25 ) .....750mW  
 V<sub>CB0</sub>——集电极—基极电压.....-20V  
 V<sub>CEO</sub>——集电极—发射极电压.....-10V  
 V<sub>EBO</sub>——发射极—基极电压.....-6V  
 I<sub>C</sub>——集电极电流.....-2A  
 I<sub>B</sub>——基极电流.....-0.2A

电参数 (T<sub>a</sub>=25 ) (TO-92)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV <sub>CBO</sub>	集电极—基极击穿电压	-20			V	I <sub>C</sub> =-1mA, I <sub>E</sub> =0
BV <sub>CEO</sub>	集电极—发射极击穿电压	-10			V	I <sub>C</sub> =-10mA, I <sub>B</sub> =0
BV <sub>EBO</sub>	发射极—基极击穿电压	-6			V	I <sub>E</sub> =-1mA, I <sub>C</sub> =0
I <sub>CBO</sub>	集电极—基极截止电流			-0.1	μA	V <sub>CB</sub> =-20V, I <sub>E</sub> =0
I <sub>EBO</sub>	发射极—基极截止电流			-0.1	μA	V <sub>EB</sub> =-6V, I <sub>C</sub> =0
h <sub>FE</sub>	直流电流增益	140		600		V <sub>CE</sub> =-1V, I <sub>C</sub> =-500mA
		70				V <sub>CE</sub> =-1V, I <sub>C</sub> =-2A
V <sub>CE(sat)</sub>	集电极—发射极饱和电压			-0.82	V	I <sub>C</sub> =-2A, I <sub>B</sub> =-50mA
V <sub>BE(on)</sub>	基极—发射极饱和电压			-1.5	V	V <sub>CE</sub> =-1V, I <sub>C</sub> =-2A
f <sub>T</sub>	特征频率		140		MHz	V <sub>CE</sub> =-1V, I <sub>C</sub> =-500mA
C <sub>ob</sub>	共基极输出电容		50		pF	V <sub>CB</sub> =-10V, I <sub>E</sub> =0, f=1MHz